

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

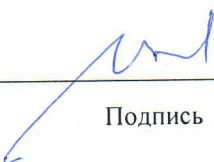
по диссертационной работе Перевощикова Дмитрия Анатольевича
«Оптические свойства и электронная структура кристаллов групп A^3B^5 , A^2B^6 и A^4B^6 », представляемой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 – «Физика конденсированного состояния».

Фамилия Имя Отчество оппонента	Хохряков Николай Владимирович
Ученая степень и отрасль науки	Кандидат физико-математических наук по специальности 01.04.02 теоретическая физика
Ученое звание	доцент
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный аграрный университет»
Занимаемая должность	директор по цифровизации и развитию информационных систем
Почтовый индекс, адрес	426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11
Телефон	8 (3412) 771747
Адрес электронной почты	khrv70@mail.ru
Согласен на обработку моих персональных данных в аттестационном деле их размещении на сайте организации и в федеральной информационной системе государственной научной аттестации. Совместных публикаций с соискателем не имею. Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:	
1. Khokhriakov N.V. First-principles research of interaction between 3d-transition metal ions and a graphene divacancy on the supercomputer base // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2021. Т. 42. № 1. С. 134-141. 2. Хохряков Н.В., Иванова А.М. Квантовохимические расчеты металл-углеродных нанокмполитов // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 3 (59). С. 63-70.	

3. Хохряков Н.В. Квантовохимические исследования взаимодействия ионов переходных металлов с дефектами графена // Химическая физика и мезоскопия. 2018. Т. 20. № 3. С. 427-436.
4. Khokhriakov N.V., Melchor S. Quantum chemistry research of interaction between 3d-transition metal ions and a defective graphene on the supercomputer base // Supercomputing Frontiers and Innovations. 2018. Т. 5. № 3. С. 79-82.
5. Яковлев Г.И., Хохряков Н.В., Полянских И.С., Орбан З., Гуменюк А.Н. Применение квантовохимического моделирования для определения механизма электрической проводимости в силикатных матрицах // Вестник МГСУ. 2022. Т. 17. Вып. 9. С. 1175–1186. DOI: 10.22227/1997-0935.2022.9.1175-1186

21.10.2022 г.

Дата



Н.В. Хохряков

Подпись

Верно

Ученый секретарь организации




МП.